

中国电子科技集团公司第十三研究所



性能特点

- 频率范围: 20~400MHz
- 采用有源偏置设计提供温度补偿
- ●良好的50Ω阻抗匹配,易级联使用
- 微波薄膜电路结构, 电性能稳定可靠
- 采用标准全密封T0-8C管壳封装
- 满足军温工作条件: -55℃~+85℃

电性能表(50Ω测试系统,V_{cc}=+15V,T_s=-55℃~+85℃)

| 性能参数 | 符号 | 单位 | 规范值 | 典型值 |
|---------|--|-----|-----------|--------|
| 频率范围 | $f_{\scriptscriptstyle L}{\sim}f_{\scriptscriptstyle H}$ | MHz | 20~400 | 10~400 |
| 小信号功率增益 | Gp | dB | ≥14.0 | 16. 0 |
| 增益平坦度 | ΔGp | dB | ≤1.0 ∆ | 0.6 |
| 噪声系数 | Fn | dB | ≤ 4.5 ∆ | 4. 0 |
| 输入驻波比 | VSWRi | - | ≤2.0:1∆ | 1.8:1 |
| 输出驻波比 | VSWRo | | ≤ 2.0:1 ∆ | 1.8:1 |
| 线性输出功率 | P_{-1} | dBm | ≥23.0* ∆ | 24. 0 |
| 工作电流 | I_{cc} | mA | | 120 |

注: 1) "*" f =300MHz; 规范值中带"Δ"的参数为常温参数。

2) V_{cc}=12V下Gp下降0.3dB, P-1下降2dB, 电流为92mA(Typ)。

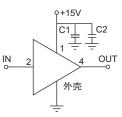
极限参数

最高电源电压: +16Vpc 最大输入功率: +10dBm 最高储存温度: +125℃

使用说明

- 1. 电路按右图连接,内部集成有耦合电容, C,=3. 3~22 μ F; C,=3300~6800pF;
- 2. 本电路直流功耗大, 使用中注意散热;
- 3. 可提供盒体结构(SMA输出)SMA-1封装 类型的产品:
- 4. 外形尺寸和安装使用方法见本册附后 的《封装外形尺寸及安装使用说明》页。





典型曲线

